

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012年6月7日(07.06.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/073384 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 16/44 (2006.01) *C23C 16/503* (2006.01)
C23C 16/27 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/071772
- (22) 国際出願日: 2010年11月29日(29.11.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社ユーテック(YOUTEC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2700156 千葉県流山市西平井956番地の1 Chiba (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 本多 祐二(HONDA, Yuuji) [JP/JP]; 〒2700156 千葉県流山市西平井956番地の1 株式会社ユーテック内 Chiba (JP). 荒木 智幸(ARAKI, Tomoyuki) [JP/JP]; 〒2700156 千葉県流山市西平井956番地の1 株式会社ユーテック内 Chiba (JP). 老川 晶久(OIKAWA, Masahisa) [JP/JP]; 〒2700156 千葉県流山市西平井956番地の1 株式会社ユーテック内

Chiba (JP). 田中 正史(TANAKA, Masafumi) [JP/JP]; 〒2700156 千葉県流山市西平井956番地の1 株式会社ユーテック内 Chiba (JP).

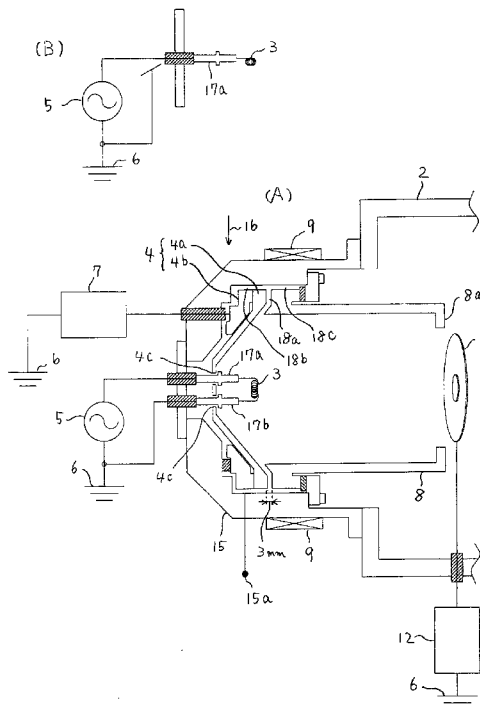
- (74) 代理人: 柳瀬 睦肇, 外(YANASE, Mutsuyasu et al.); 〒1690075 東京都新宿区高田馬場1丁目32番14号 UKビル8階 進歩国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ

[続葉有]

(54) Title: PLASMA CVD DEVICE, MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: プラズマCVD装置、磁気記録媒体及びその製造方法

図1



(57) Abstract: Provided is a plasma CVD device in which discharge at the rear face of an anode can be suppressed. The plasma CVD device of the present invention is characterized by comprising: a chamber; a plasma wall (8) which is arranged within the chamber and has openings at both ends; a holding part which holds a substrate (1) on which a film is to be deposited, the substrate (1) being arranged in the vicinity of an opening at one end of the plasma wall; an anode which is arranged so as to cover the opening at the other end of the plasma wall; a filament-shaped cathode which is arranged inside of the anode and in the vicinity of the opening at the other end of the plasma wall; an AC power source which is electrically connected to one end of the cathode by way of a first wire, and is electrically connected to the other end of the cathode by way of a second wire; and holes which are provided in the anode and have the first and second wires passing therethrough.

(57) 要約: アノードの背面で放電が生じるのを抑制できるプラズマCVD装置を提供する。本発明のプラズマCVD装置は、チャンバーと、チャンバー内に配置され、両端が開口されたプラズマウォール8と、プラズマウォールの一方端の開口近傍に配置された被成膜基板1を保持する保持部と、プラズマウォールの他方端の開口を覆うように配置されたアノードと、アノードの内側で且つプラズマウォールの他方端の開口近傍に配置されたフィラメント状のカソードと、カソードの一端に第1の配線を介して電氣的に接続され、カソードの他端に第2の配線を介して電氣的に接続された交流電源と、アノードに設けられ、第1及び第2の配線それぞれが通る孔と、を具備することを特徴とする。



(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))